

КТ814А, КТ814Б, КТ814В, КТ814Г

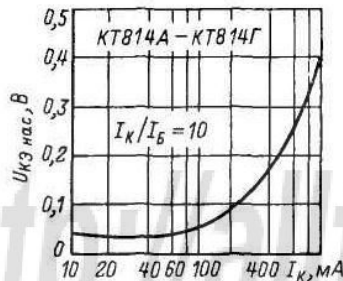
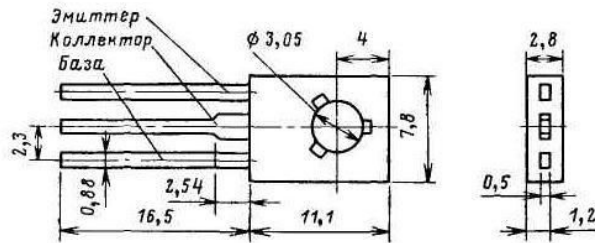
Электрические параметры

Транзисторы кремниевые меза-эпитаксиально-планарные *p-n-p* универсальные низкочастотные мощные

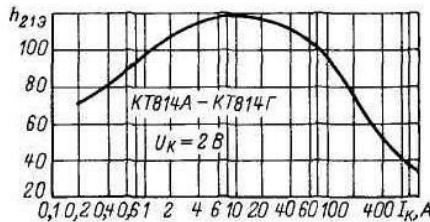
Предназначены для работы в усилителях низкой частоты, операционных и дифференциальных усилителях, преобразователях, импульсных схемах

Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе.

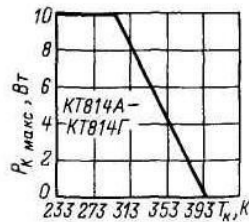
Масса транзистора не более 1 г.



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора



Зависимость максимально допустимой постоянной рассеиваемой мощности коллектора от температуры корпуса

Граничное напряжение при $I_3 = 50$ мА, $\tau_{и} \leq 300$ мкс, $Q \geq 100$ не менее:

КТ814А	25 В
КТ814Б	40 В
КТ814В	60 В
КТ814Г	80 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_{К} = 0,5$ А, $I_{Б} = 0,05$ А не более

0,6 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_{К} = 0,5$ А, $I_{Б} = 0,05$ А не более

1,2 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 2$ В, $I_3 = 0,15$ А не менее:

КТ814А, КТ814Б, КТ814В	40
КТ814Г	30

Граничная частота коэффициента передачи тока при $U_{КЭ} = 5$ В, $I_3 = 0,03$ А не менее

3 МГц

Емкость коллекторного перехода при $U_{КЭ} = 5$ В, $f = 465$ кГц не более

60 пФ

Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0,5$ В, $f = 465$ кГц не более

75 пФ

Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 40$ В не более при $T_{к} \leq 298$ К

50 мкА

при $T_{к} = 373$ К 1000 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} \leq 100$ Ом

КТ814А	40 В
КТ814Б	50 В
КТ814В	70 В
КТ814Г	100 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $I_{Б} = 0$

КТ814А	25 В
КТ815Б	40 В
КТ815В	60 В
КТ815Г	80 В

Постоянное напряжение база-эмиттер 5 В

Постоянный ток коллектора 1,5 А

Импульсный ток коллектора при $\tau_{и} \leq 10$ мс, $Q \geq 100$ 3 А

Постоянный ток базы 0,5 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом при $T_{к} \leq 298$ К 10 Вт

без теплоотвода при $T = 233 - 298$ К 1 Вт

Температура перехода 298 К

Температура окружающей среды От 233 до $T_{к} = 373$ К

Примечания: 1. Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода при $T = 298 - 373$ К снижается линейно на 0,01 Вт через 1 К и с теплоотводом при $T_{к} = 298 - 373$ К на 0,1 Вт через 1 К

2. Пайку выводов разрешается производить на расстоянии не менее 5 мм от корпуса. При пайке жало паяльника должно быть заземлено.

Изгиб выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5-2 мм, при этом должны приниматься меры, исключающие возможность передачи усилий на корпус. Изгиб в плоскости выводов не допускается.